金属絶縁体転移に伴う Culr₂S₄の lr 5d-S 3p 混成バンドの変化

田口幸広, 中島裕一, 三村功次郎, 川邑典之, 塩見健, 市川公一, 石橋広記^A 阪府大院工, ^A阪府大院理

スピネル型構造をもつ Culr₂S₄は,室温から温度を下げていくと,約 230 K で同時に構造,金 属 絶縁体および常磁性 反磁性転移を示す.また,転移の際にIrイオンが電荷分離しユニーク な秩序配列をすると考えられている[1].転移と密接に関係するフェルミ準位 E_F 近傍は,エネル ギーバンド計算[2]によれば Ir 5d-S 3p 混成バンドであるが, Ir 5d 電子構造に関してはバンド計算 と価電子帯光電子スペクトルとで不一致が見られる[3]. CuIr2S4のSKXAS測定[4]では,金属 絶縁体転移に伴って, EF 近傍の非占有状態密度が減少し, 1.5 eV 程度上の状態密度が増加するの が観測されている.今回, 我々は, Culr₂S₄の占有電子状態側の Ir 5d-S 3p 混成バンドの温度変化 を調べるために SL23 軟X線発光スペクトルを測定した 実験はBL-19B で行った 試料はCuIr2S4 多結晶焼結体で、真空槽内でやすりがけによって表面を清浄化し,275 および40Kの温度で測定 した.図1にCuIr₂S₄のSL_{2.3}発光スペクトルを示す.S2p_{1/2}準位の結合エネルギーを参照して結 合エネルギー表示に変換し,S3s 2p発光線のピーク強度で規格化した.SL2.3 スペクトルでは価 電子帯 S 2p1/2 (L2) および 2p2/3 (L3) への遷移が同時に観測されるので,いくつかの単純な仮定 を行なって L_2 および L_3 成分へ分解した.図 2 に得られた S L_2 発光スペクトルを示す。低温の絶 縁体相になると, E_Fから2 eV 付近の発光強度が減少して, 3.0 eV 付近の強度が増加しているの がわかる.この転移に伴う状態密度の再分布が化学ポテンシャルシフト[5]の原因と考えられる. [1] Furubayashi et al., JPSJ 63, 3333 (1994), Nagata et al., PRB 58, 6844 (1998), Radaelli et al., Nature 416, 155 (2002). [2] Sasaki et al., JPSJ 73, 1875 (2004), Oda et al., J. Phys.: Condens. Matter 7, 4433 (1995).

[3] Matsuno et al., PRB 55, R15979 (1997).

[4] Croft et al., PRB 67, 201102(R) (2003).

[5] Takubo et al., PRL 95, 246401 (2005).



図 1 . 275 (赤)および 40 (青) K における CuIr₂S₄ の S *L*_{2,3} 発光スペクトル .



図 2.分解して得られた 275 (赤) および 40 (青) K での S L₂ 発光スペクトル.